

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成26年9月25日(2014.9.25)

【公開番号】特開2013-58324(P2013-58324A)

【公開日】平成25年3月28日(2013.3.28)

【年通号数】公開・登録公報2013-015

【出願番号】特願2011-194811(P2011-194811)

【国際特許分類】

H 05 B 33/12 (2006.01)

H 01 L 51/50 (2006.01)

H 05 B 33/24 (2006.01)

【F I】

H 05 B 33/12 B

H 05 B 33/14 A

H 05 B 33/24

【手続補正書】

【提出日】平成26年8月13日(2014.8.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の開口からなる集合体をサブピクセルごとに備え、

前記集合体は、各開口が最密充填配置された配列構造となっており、さらに、当該集合体の周縁領域に仮想開口を1つ置いたときに、前記仮想開口の中心点と、前記仮想開口に隣接する複数の開口の中心点とを線で結ぶと前記最密充填配置の基本形状が1つだけ形成され、2つは形成されない配列構造となっている

発光パネル。

【請求項2】

前記サブピクセルは、自発光素子と、前記自発光素子で発せられた光の発散角を狭める複数の反射構造とを有し、

各反射構造は、前記開口と、前記自発光素子で発せられた光を反射する反射面とを有している

請求項1に記載の発光パネル。

【請求項3】

前記自発光素子は、有機層を反射電極および透明電極で挟み込んだ構造となっており、

各反射構造は、前記反射電極の上面に接して形成され、

前記有機層および前記透明電極は、少なくとも前記開口の底部に形成されている

請求項2に記載の発光パネル。

【請求項4】

前記反射電極は、前記集合体の平面形状に対応した平面形状となっている

請求項3に記載の発光パネル。

【請求項5】

前記サブピクセルは、前記反射電極の平面形状に対応した平面形状となっている

請求項4に記載の発光パネル。

【請求項6】

前記集合体は、六角形状となっている
請求項 3 に記載の発光パネル。

【請求項 7】

前記集合体は、台形状となっている
請求項 3 に記載の発光パネル。

【請求項 8】

前記集合体は、傾斜した長方形状となっている
請求項 3 に記載の発光パネル。

【請求項 9】

前記最密充填配置の基本形状は、三角形である
請求項 1 ないし請求項 8 のいずれか一項に記載の発光パネル。

【請求項 10】

前記開口は、点対称の形状となっている
請求項 1 ないし請求項 9 のいずれか一項に記載の発光パネル。

【請求項 11】

表示パネルと、前記表示パネルを駆動する駆動回路とを備え、
前記表示パネルは、

複数の開口からなる集合体をサブピクセルごとに備え、

前記集合体は、各開口が最密充填配置された配列構造となっており、さらに、当該集合体の周縁領域に仮想開口を 1 つ置いたときに、前記仮想開口の中心点と、前記仮想開口に隣接する複数の開口の中心点とを線で結ぶと前記最密充填配置の基本形状が 1 つだけ形成され、2 つは形成されない配列構造となっている

表示装置。

【請求項 12】

表示装置を備え、

前記表示装置は、表示パネルと、前記表示パネルを駆動する駆動回路とを有し、

前記表示パネルは、複数の開口からなる集合体をサブピクセルごとに有し、

前記集合体は、各開口が最密充填配置された配列構造となっており、さらに、当該集合体の周縁領域に仮想開口を 1 つ置いたときに、前記仮想開口の中心点と、前記仮想開口に隣接する複数の開口の中心点とを線で結ぶと前記最密充填配置の基本形状が 1 つだけ形成され、2 つは形成されない配列構造となっている

電子機器。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 2】

データ線駆動回路 2 3 は、制御信号 2 1 A の入力に応じて（同期して）、映像信号処理回路 2 2 から入力されたアナログの信号電圧 2 2 B を、各データ線 D T L を介して、選択対象の表示画素 1 4 （またはサブピクセル 1 3 ）に書き込むものである。データ線駆動回路 2 3 は、例えば、信号電圧 2 2 B と、映像信号 2 0 A とは無関係の一定電圧とを出力することが可能となっている。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 6 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 6 6】

また、上記実施の形態等では、書きトランジスタ T w s および駆動トランジスタ T d r

がnチャネルMOS型のTFTにより形成されているものとして説明されていたが、書込トランジスタTwSおよび駆動トランジスタTdrの少なくとも一方がpチャネルMOS型のTFTにより形成されていてもよい。なお、駆動トランジスタTdrがpチャネルMOS型のTFTにより形成されている場合には、上記実施の形態等において、有機EL素子11のアノードがカソードとなり、有機EL素子11のカソードがアノードとなる。また、上記実施の形態等において、書込トランジスタTwSおよび駆動トランジスタTdrは、常に、アモルファスシリコン型のTFTやマイクロシリコン型のTFTである必要はなく、例えば、低温ポリシリコン型のTFTであってもよい。